

LTK5210 2×7.9W 带耳机模式F类、双声道立体声音频放大器

■ 概述

LTK5210 是一款 3Ω-7.9W、自带耳机切换功能双声道 F 类音频功率放大器。LTK5210 能实现耳机模式和功放模式切换，当芯片切换到耳机模式时芯片内部电路可以驱动立体声耳机工作，切换功放模式可以立体声音箱工作。LTK5210 同时采用高耐压工艺，耐压可达 7V。同时具有一线脉冲功能，可控制单个管脚使芯片进入 D 类、AB 类模式、关断模式，达到节省 IO 口的目的，LTK5210 在 AB 类模式可以完全消除 EMI 干扰。在 D 类放大器模式下可以提供高于 90%的效率，新型的无滤波器结构可以省去传统 D 类放大器的输低通滤波器，LTK5210 独有的 DRC (Dynamic range control) 技术，降低了大功率输出时，由于波形切顶带来的失真，相比同类产品，动态反应更加出色。LTK5210 采用 ESOP_10 封装。

■ 特性

- 输入电压范围 2.8V-7V
- 自带耳机切换模式
- 一线脉冲控制
- 无滤波的 D 类/AB 类放大器、低静态电流和低 EMI
- FM 模式无干扰
- 优异的爆破声抑制电路
- 超低底噪、超低失真
- 10% THD+N, VDD=7V, 3Ω+15UH 负载下提供高达 2×7.9W 的输出功率
- 10% THD+N, VDD=7V, 4Ω+33UH 负载下提供高达 2×6.6W 的输出功率
- 过温保护、短路保护
- 封装形式 ESOP_10
- 关断电流 < 1ua

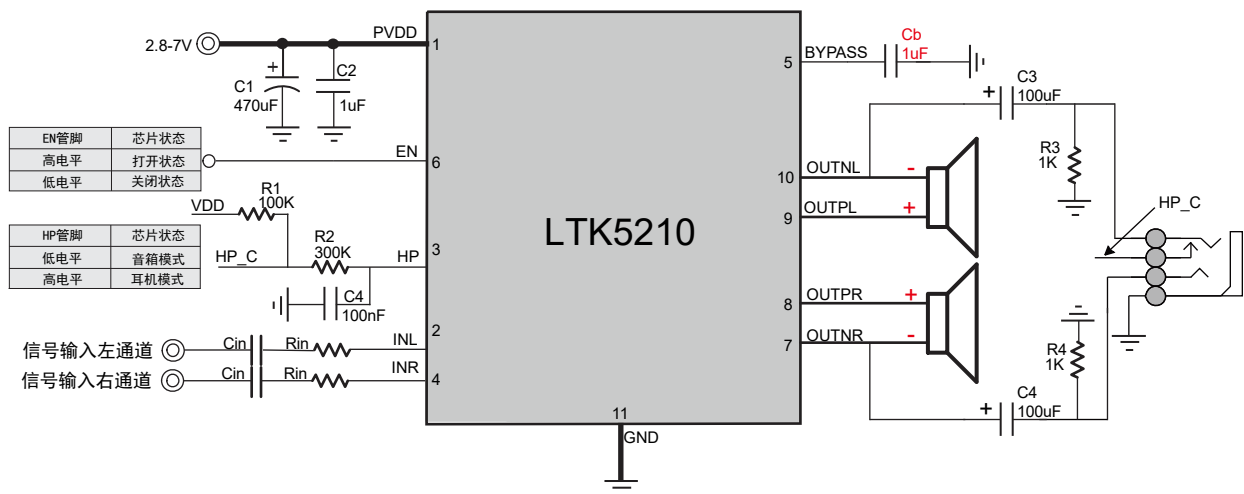
■ 应用

- 收音机、扩音器
- 导航仪、便携游戏机、玩具类
- 拉杆音箱、DVD、USB 对箱
- 智能家居等各类音频产品

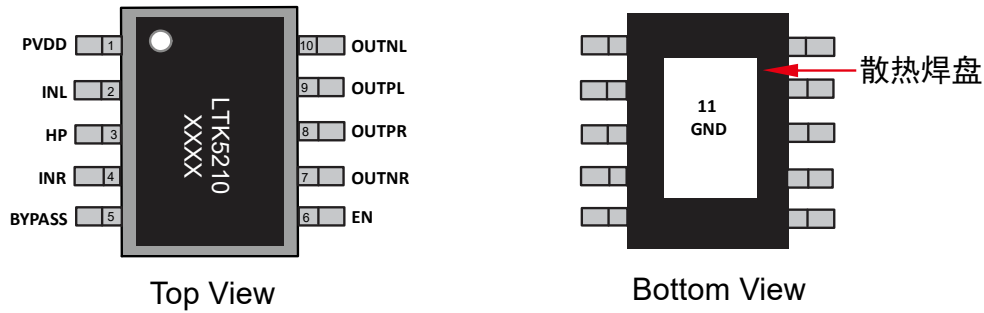
■ 封装

芯片型号	封装类型	封装尺寸
LTK5210	ESOP_10	

■ 典型应用图



■ 管脚说明及定义



管脚编号	管脚名称	IO	功 能
1	PVDD	I	电源正端
2	INL	I	左通道输入
3	HP	I	耳机/音箱模式控制, 高电平为耳机模式, 低电平为音箱模式
4	INR	I	右通道输入
5	BYPASS	I	内部模拟基准源, 接旁路电容下地
6	EN	I	芯片关断控制, 低电平关断, 高电平为打开。
7	OUTNR	O	右通道反向输出
8	OUTPR	O	右通道正向输出
9	OUTPL	O	左通道正向输出
10	OUTNR	O	左通道反向输出
11	GND	GND	芯片底部露铜接地端, 电源负端

■ 最大极限值

参数名称	符号	数值	单位
供电电压	VDD	7V(MAX)	V
存储温度	TSTG	-65°C-150°C	°C
结温度	TJ	160°C	°C

■ 推荐工作范围

参数名称	符号	数值	单位
供电电压	VDD	3-6.7V	V
工作环境温度	TSTG	-40°C to 85°C	°C
结温度	TJ	-	°C

■ ESD 信息

参数名称	符号	数值	单位
人体静电	HBM	±2000	V
机器模型静电	CDM	±300	V

■ 基本电气特性

$A_V=20\text{dB}$, $T_A=25^\circ\text{C}$, 无特殊说明的项目均是在 $V_{DD}=5\text{V}$, $4\Omega+33\mu\text{H}$ 条件下测试:

描述	符号	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
静态电流	I_{DD}	$V_{DD}=5\text{V}$, D类		-	18	23	mA
		$V_{DD}=5\text{V}$, AB类			20	24	mA
关断电流	I_{SHDN}	$V_{DD}=3\text{V to }5\text{V}$		-	1		μA
静态底噪	V_n	$V_{DD}=5\text{V}$, $A_V=20\text{DB}$, $A_{w\text{ting}}$			130		μV
D类频率	F_{SW}	$V_{DD}=5\text{V}$			750		kHz
输出失调电压	V_{os}	$V_{IN}=0\text{V}$			10		mV
启动时间	T_{start}	$V_{dd}=5\text{V}$, $Bypass=1\mu\text{F}$			170		ms
增益	A_V	D类模式, $R_{IN}=27\text{k}$			≈ 20.5		dB
电源关闭电压	V_{ddEN}	EN=1			<1.6		V
电源开启电压	V_{ddopen}	EN=1			>2.8		V
EN关断电压	V_{ENEN}				<0.7		V
EN开启电压	V_{ENopen}				>1.3		V
D类开启电压	$MODE_{/D}$				<0.7		V
AB类开启电压	$MODE_{/AB}$				>1.8		V
过温保护	O_{TP}				180		$^\circ\text{C}$
静态导通电阻	R_{DSON}	$I_{DS}=0.5\text{A}$ $V_{GS}=4.2\text{V}$	P_MOSFET		150		m Ω
			N_MOSFET		120		
内置输入电阻	R_s				7.5K		k Ω
内置反馈电阻	R_f				185K		k Ω
效率	η_C				90.3		%

● Class_D功率

$A_V=20\text{dB}$, $T_A=25^\circ\text{C}$, 无特殊说明的项目均是在 $V_{DD}=5\text{V}$, 4Ω 条件下测试:

参数	符号	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
输出功率	P_o	THD+N=10%, $f=1\text{kHz}$, $R_L=4\Omega$;	$V_{DD}=7\text{V}$	-	6.6	-	W
			$V_{DD}=6\text{V}$	-	4.9	-	
			$V_{DD}=5\text{V}$		3.2		
			$V_{DD}=4.2\text{V}$		2.2		
		THD+N=10%, $f=1\text{kHz}$, $R_L=3\Omega$;	$V_{DD}=7\text{V}$	-	7.9	-	W
			$V_{DD}=6\text{V}$		5.6		
			$V_{DD}=5\text{V}$		4.1		
			$V_{DD}=4.2\text{V}$	-	2.9	-	
总谐波失真加噪声	THD+N	$V_{DD}=5\text{V}$, $P_o=1\text{W}$, $R_L=4\Omega$	$f=1\text{kHz}$	-	0.08	-	%

■ **性能特性曲线**

● **特性曲线测试条件($T_A=25^{\circ}C$)**

描述	测试条件	编号
Input Amplitude VS. Output Amplitude	$V_{DD}=5V, R_L=4\Omega+33\mu H, \text{Class}_D$	图1
Output Power VS. THD+N _{Class_D}	$R_L=3\Omega+22\mu H, A_v=20dB, \text{Class}_D$	图2
	$R_L=4\Omega+33\mu H, A_v=20dB, \text{Class}_D$	图3
Output Power VS. THD+N _{Class_AB}	$R_L=4\Omega, A_v=20dB, \text{Class}_{AB}$	图4
Frequency VS. THD+N	$V_{DD}=5V, R_L=4\Omega, A_v=20dB, P_o=1W, \text{Class}_D \text{ Awting}$	图5
Input Voltage VS. Power Crrrent	$V_{DD}=3.0V-5V, \text{Class}_D$	图6
Input Voltage VS. Maximum Output Power	$R_L=4\Omega+33\mu H, THD=10\%, \text{Class}_D$	图7
Frequency Response	$V_{DD}=5V, R_L=4\Omega, \text{Class}_D$	图8

● **特性曲线图($T_A=25^{\circ}C$)**

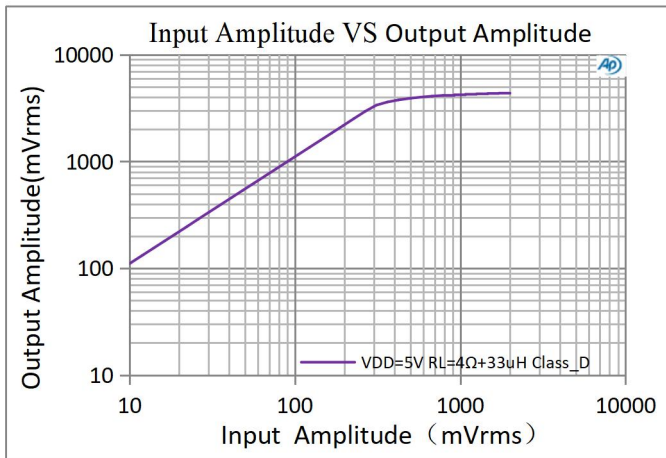


图1: Input Amplitude VS. Output Amplitude

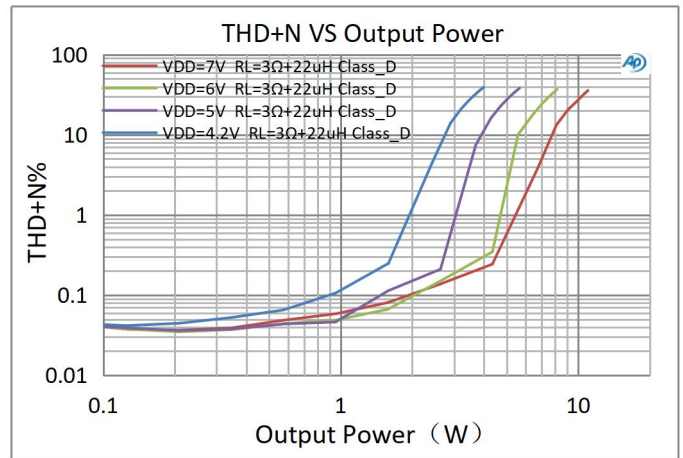


图2: THD+N VS. Output Power Class_D

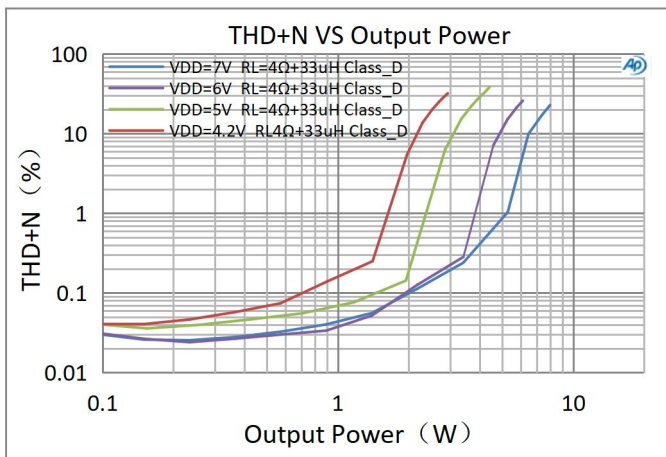


图3: THD+N VS. Output Power Class_D

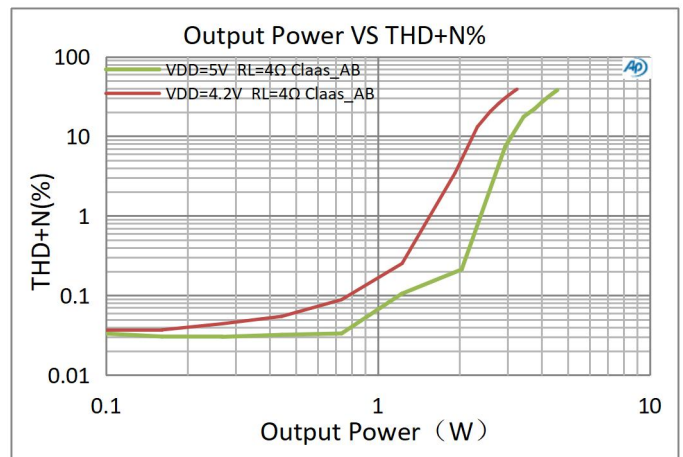


图4: THD+N VS. Output Power Class_AB

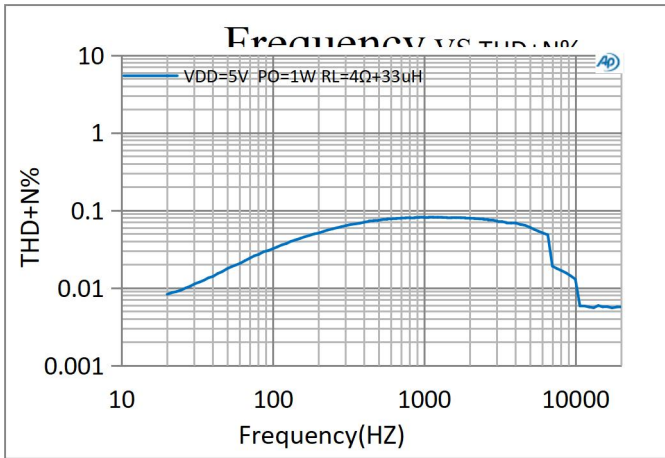


图5: Frequency VS. THD+N

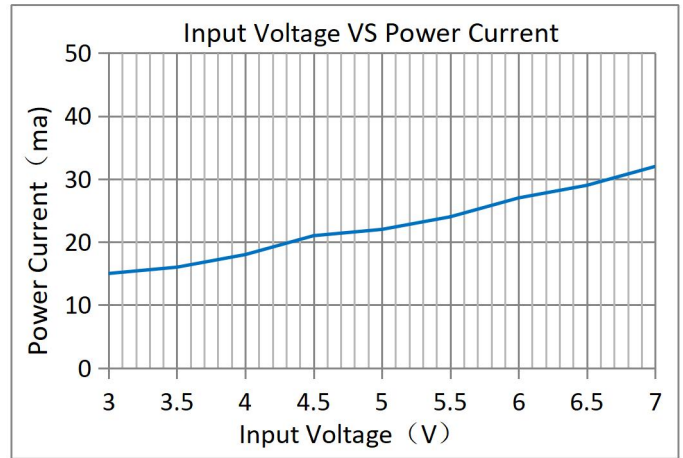


图6: Power Current VS. Supply Voltage

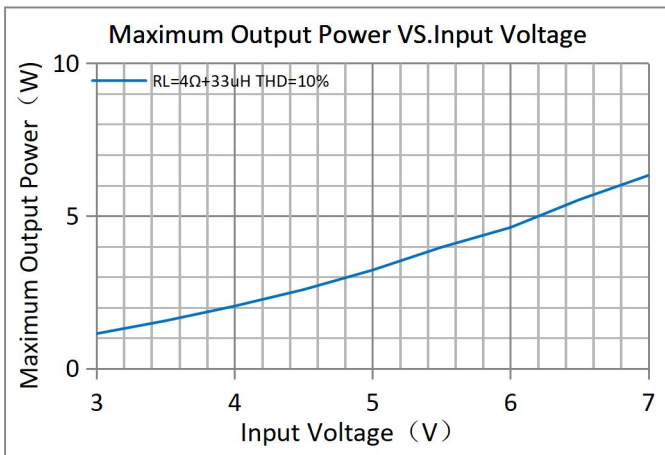


图7: Input Voltage VS. Maximum Output Power

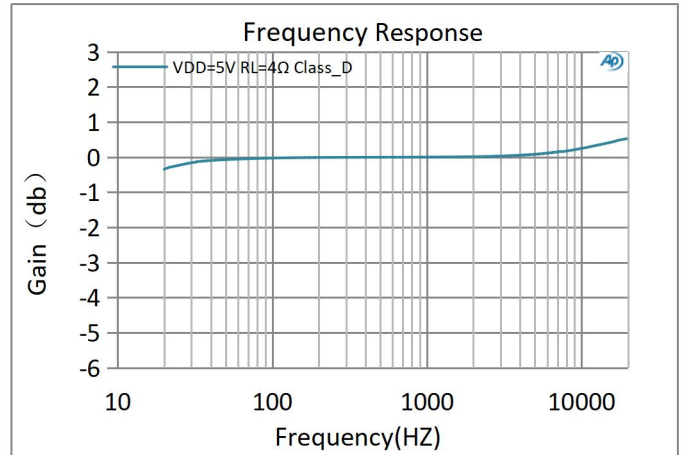


图8: Frequency Response

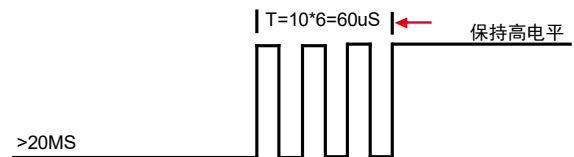
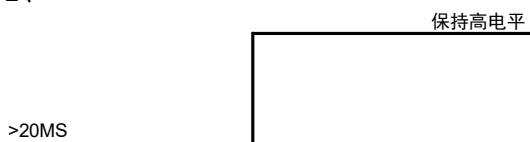
应用说明

● EN管脚控制

LTK5210有可以通过控制EN脚来控制D类、AB类模糊切换：一线脉冲控制的好处是可以节省主控IO，仅使用一个IO口即可切换功放多种工作模式。

EN管脚软件控制（一线脉冲）：EN管脚输入不同脉冲信号切换功放AB类、D类模式。

- 1、芯片切换到D类模式波形：
- 2、

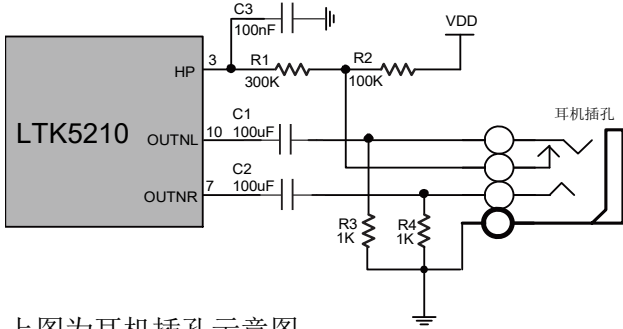


● HP模式控制

当HP脚为高电平时，芯片为耳机模式，输出为单端，为低电平时，芯片为音箱模式

HP管脚	芯片状态
高电平	耳机模式
低电平	音箱模式

- 2、芯片切换到AB类模式波形：



上图为耳机插孔示意图:

当无耳机插入时, HP脚通过R2和R3分压, 导致HP点电位为低电平, 芯片工作在音箱音箱模式。

当耳机插入时, 耳机内部短路脚分开, R2和R3不再组成分压, HP为高电平, 芯片进入耳机模式, 输出为单端输出。

● 功放增益控制

D类模式时输出为(PWM信号)数字信号, 拟信号, 其增益均可通过 R_{IN} 调节。

$$A_v = 2 \times \frac{185 K\Omega}{(R_{IN} + 7.5 K\Omega)}$$

A_v 为增益, 通常用DB表示, 上述计算结果单位为倍数、 20Log 倍数=dB。

R_{IN} 电阻的单位为 $K\Omega$ 、 $185K\Omega$ 为内部反馈电阻

(R_F), $7.5K\Omega$ 为内置串联电阻 (R_S), R_{IN} 由用户根据实际供电电压、输入幅度、和失真度定义。如 $R_{IN}=27K$ 时, $=10.5$ 倍、 $A_v=20.4\text{DB}$

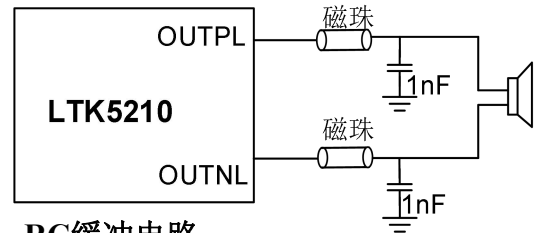
输入电容 (C_{IN}) 和输入电阻 (R_{IN}) 组成高通滤波器, 其截止频率为:

$$f_c = \frac{1}{2\pi \times (R_{IN} + 7.5K) \times C_{IN}}$$

C_{in} 电容选取较小值时, 可以滤除从输入端耦合入的低频噪声, 同时有助于减小开启时的POPO

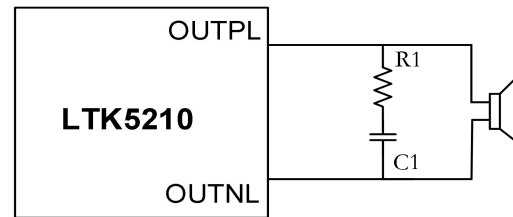
● EMI处理

对于输出走线较长或靠近敏感器件时, 建议加上磁珠和电容, 能有效减小EMI。器件靠近芯片放置。



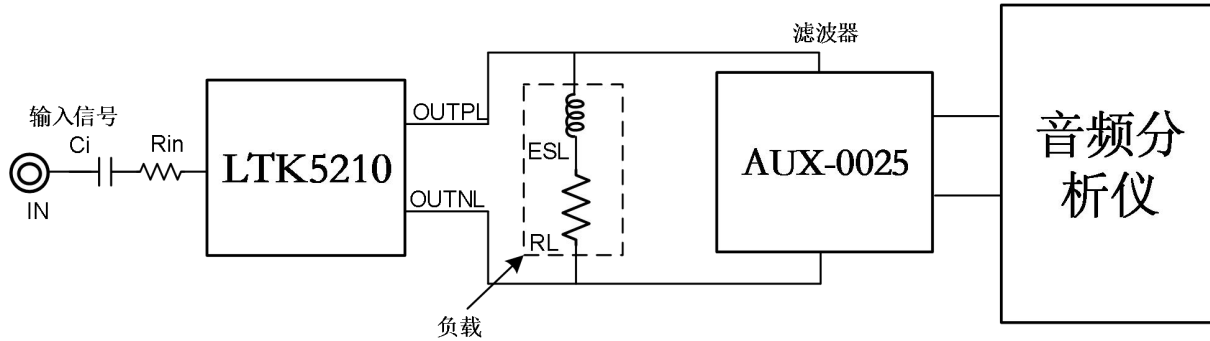
● RC缓冲电路

如喇叭负载阻抗值较小时, 建议在输出端并一个电阻和一个电容来吸收电压尖峰, 防止芯片工作异常。电阻推荐使用: $2\Omega-5\Omega$, 电容推荐: $500\text{PF}-10\text{NF}$ 。



■ 测试方法

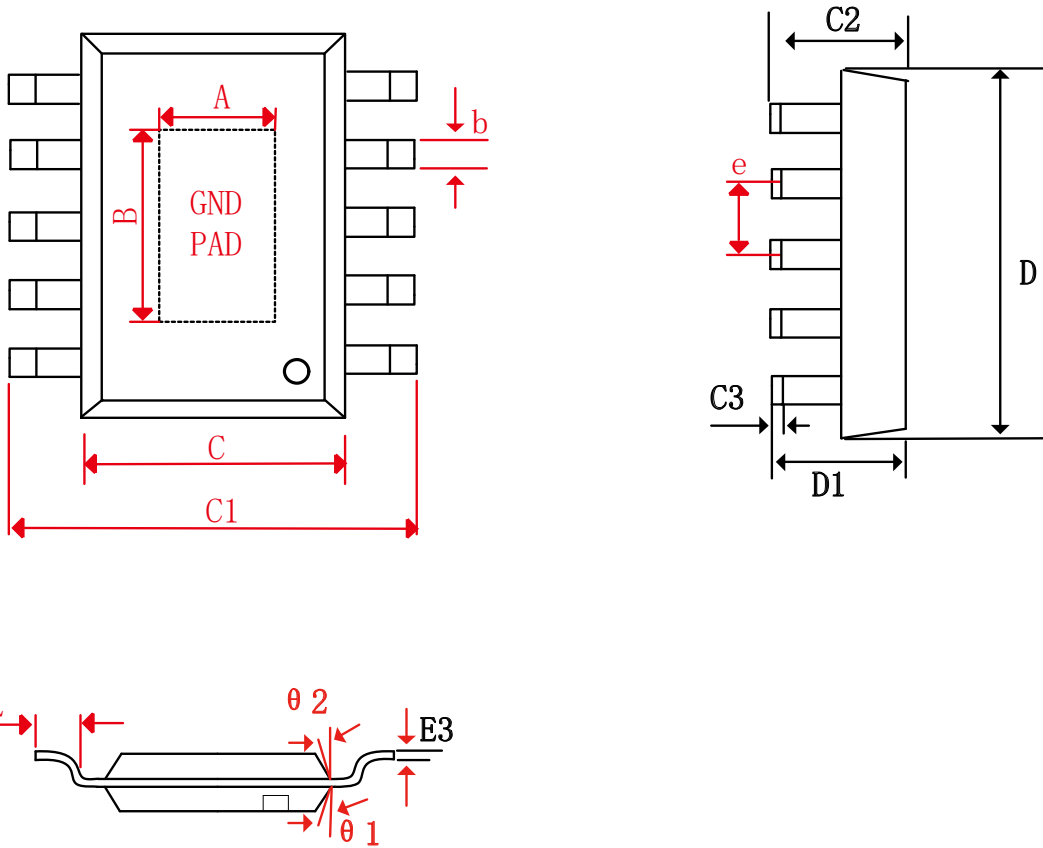
在测试D类模式时必须加滤波器测试。AUX-0025为滤波器。为了测试数据精准并符合实际应用，在RL负载端串联一个电感，模拟喇叭中的寄生电感。



■ PCB设计注意事项

- 电源供电脚（VDD、PVDDL、PVDDR）走线尽量粗，如电源走线中必须打过孔应使用多孔连接，并加大过孔内径，不可使用单个过孔直接将电源走线连接,电源电容和尽量靠近管脚放置。
- 输入电容（Cin）、输入电阻（Rin）尽量靠近功放芯片管脚放置，走线最好使用包地方式，可以有效的抑制其他信号耦合的噪声。
- Bypass 电容尽量靠近芯片管脚放置。
- LTK5210 的底部散热片建议焊接在 PCB 板上，用于芯片散热，建议 PCB 使用大面积敷铜来连接芯片中间的散热片，并有一定范围的露铜，帮助芯片散热。
- LTK5210 输出连接到喇叭的管脚走线管脚尽可能的短，并且走线宽度需在 0.4mm 以上

■ 芯片封装 ESOP-10



Symbol	Dimensions In Milli meters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.80	2.10	0.070	0.082
B	3.10	3.40	0.122	0.133
b	0.38	0.50	0.015	0.019
C	3.80	4.00	0.149	0.157
C1	6.00	6.20	0.236	0.244
C2	1.35	1.55	0.053	0.061
C3	0.1	0.25	0.004	0.010
D	4.8	5.0	0.189	0.197
D1	1.35	1.55	0.053	0.061
e	1.00(BSC)		0.039(BSC)	
L	0.520	0.720	0.02	0.028
θ	0°		8°	

声明：深圳市思泽远电子有限公司保留在任何时间、不另行通知的情况下对规格书的更改权。
深圳市思泽远电子有限公司提醒：请务必严格应用建议和推荐工作条件使用。如超出推荐工作条件以及不按应用建议使用，本公司不保证产品后续的任何售后问题。